4407/W

30V P 沟道增加型 MOS 场效应管

VDS= -30V

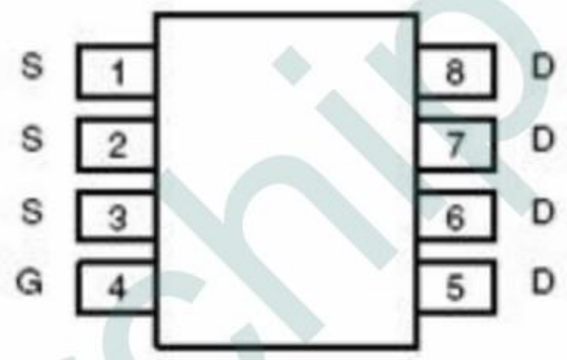
RDS(ON), Vgs@-10V, Ids@-12A = 8.5mΩ@TY

RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-12A = 11.8mΩ@TYP

产品特征

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计
- 改良的成型工艺

引脚示意图



SOP-8

最大额定值和热特性 (T_A=25℃，除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	-30	V
栅源电压	V_{GS}	±20	
漏极电流	I_D	-12	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	-42	
工作结温和存储温度范围	T_J, T_{stg}	-55 to 150	℃

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

www.superchip.cn